VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 0 6 APR 2006

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

	enzeichen des Anmelders oder Anwa 04P04704WO	weiteres vorg	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
l l		Internationales Anmeldo 02.03.2005	edatum <i>(TagMonat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (TagMonat/Jahr) 29.04.2004	
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. H05K1/00 H05K1/11 H05K3/40 H05K3/42					
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT					
1.	 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 				
2.	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
3.	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
	a. 🛛 (an den Anmelder und	das Internationale Büro ge	esandt) insgesamt 2 Blät	tter; dabei handelt es sich um	
	☑ Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).				
	Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.				
	b. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).				
4.	Dieser Bericht enthält Angabe	n zu folgenden Punkten:			
	☐ Feld Nr. I Grundlage of	les Berichts			
	☐ Feld Nr. II Priorität				
	☐ Feld Nr. III Keine Erste Anwendbar	llung eines Gutachtens übe eit	er Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche	
	☐ Feld Nr. IV Mangelnde	Einheitlichkeit der Erfindun	g		
				heit, der erfinderischen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung	
		angeführte Unterlagen			
		Mängel der internationalen	-		
	☐ Feld Nr. VIII Bestimmte	Bemerkungen zur internatio	onalen Anmeldung		
Datu	um der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts	
23.0	02.2006		05.04.2006		
	ne und Postanschrift der mit der inte	rnationalen vorläufigen	Bevollmächtigter Bediens	steterches Patenta	
Prüfung beauftragten Behörde Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d			Molenaar, E	To the state of th	
Fax: +49 89 2399 - 4465			Tel. +49 89 2399-2159	apply and apply and apply and apply and apply ap	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/050919

	Feld Nr. I Grundlage des Ber	ichts	
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		
	bei der es sich um die Sprac ☐ internationale Recherche ☐ Veröffentlichung der inte	Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, che der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: e (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) rnationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)	
2.	Hinsichtlich der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die der Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berich "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt</i>):		
	Beschreibung, Seiten		
	1, 3-6	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	2, 2a	eingereicht mit dem Antrag	
	Ansprüche, Nr.		
	1-5	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	Zeichnungen, Blätter		
	1/1	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	☐ einem Sequenzprotokoll un Sequenzprotokoll	d/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das	
3.	 Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 		
4.	aufgelisteten Änderungen erstel Auffassung der Behörde über de (Regel 70.2 c)). Beschreibung: Seite Ansprüche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoll (gena. etwaige zum Sequenzpr	rotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :	
	* Wenn Punkt 4 zutrifft "ersetzt" versehen werde	t, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung en.	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/050919

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-5

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche 1-5 Ja:

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-5

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2005/050919

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechende Konstrukten nach Anspruch 1.

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO 02/078411 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; BUSCH, GEORG) 3. Oktober 2002 (2002-10-03)

D2 US-A-5 758 413 (CHONG ET AL) 2. Juni 1998 (1998-06-02)

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart als Stand der Technik (Seite 2, Zeile 9 -Seite 3, Zeile 5 und Seite 4 Zeile 12 - Seite 5, Zeile 25; Figuren 1-3) ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen (133) realisiert sind, zumindest in deren Nähe weiter Leiterbahnen (15,120) oder eine elektrisch leitende Schicht vorgesehen sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem bekannten Verfahren durch das Bohren von im Größenbereich von 20 Mikrometer liegenden Durchgangsbohrungen für die Durchkontaktierungen und durch das Durchkontaktieren, indem eine elektrisch leitende Gesamtschicht aufgebaut wird, bevor die Durchgänge mit einem Standardmittel gefüllt werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß Durchkontaktierungen im Größenbereich von 20 Mikrometer mit einer leitenden Beschichtung und außerdem danach mit einem Standardmittel aufgefüllt, realisiert werden

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050919

müssen.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) weil die vorhandenen Dokumente keinen Hinweis auf die Kombination der kennzeichnenden Merkmale geben.

Dokument D2 offenbart <u>nur für die Vias (24,26,27,28,29)</u> ein Größenbereich von **120** Mikrometer oder weniger (Spalte 4, Zeile 49-52).

Die Ansprüche 2 - 5 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

25

Bei den Kurzschlüssen muss es sich dabei nicht zwangsläufig jeweils um extrem niederohmige Kurzschlüsse handeln. Kurzschlüsse sind auch dann vorhanden, wenn der Isolationswiderstand kleiner Unendlich wird, so dass die Möglichkeit besteht, dass Kriechströme fließen.

Aus dem Dokument WO 02/078411 A ist ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten mit Stellen bekannt, an denen
Durchkontaktierungen realisiert sind, zumindest in deren Nähe
weiter Leiterbahnen oder eine elektrisch leitende Schicht
vorgesehen ist. Dabei weisen die Durchgangsbohrungen der
Durchkontaktierungen Durchmesser auf, die oberhalb eines
Größenbereichs von 20 Mikrometer sind. Weiter fehlt ein Verfahrensschritt, in dem das Durchkontaktieren dadurch erfolgt,
dass eine elektrisch leitende Gesamtschicht aufgebaut wird,
bevor die Durchgänge mit einem Standardmittel gefüllt werden.

Aus dem Dokument US-A-5 758 413 ist ein Verfahren zur Herstellung von Mehrlagenleiterplatten bekannt mit nur für die Durchkontaktierungen einen Durchmesser von 120 Mikrometer und weniger.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein einfaches und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen realisiert sind, zumindest in deren Nähe weiter Leiterbahnen oder Ähnliches vorgesehen sind, anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gelöst, das die im Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte aufweist.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es einfach in der Ab-35 wicklung ist und dass trotzdem sichergestellt ist, dass keine Kurzschlüsse zwischen den Durchkontaktierungen und den zumindest in der Nähe der Durchkontaktierungen angeordneten Leiterbahnen oder dementsprechend Ähnlichen fabriziert sind.

Das Verfahren ist einfach in der Abwicklung und es ist kostengünstig, weil insbesondere ein sehr aufwendiger Bürst-Verfahrensschritt, in dem die Oberfläche der Leiterplatte oder eines entsprechenden Konstrukts gebürstet wird, eingespart wird. Das Verfahren ist auch deshalb einfach und kostengünstig, weil durchwegs Standardmittel verwendbar sind und es somit nicht notwendig ist, Spezialmittel zumindest bei manchen Verfahrensschritten zu verwenden. Das Verfahren gewährleistet die Kurzschlusssicherheit insbesondere auch oberhalb der Durchkontaktierungen, weil oberhalb der Durchkontaktierungen praktisch drei Isolierschichten aufgebracht sind. Erstens ist damit eine insgesamt relativ dicke Gesamtisolierschicht realisiert und ist zweitens die Wahrscheinlichkeit,